

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年3月3日(03.03.2022)



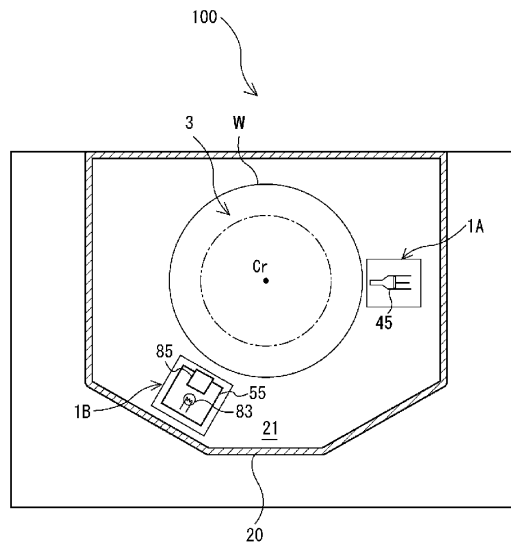
(10) 国際公開番号

WO 2022/044522 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/02 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/024080
- (22) 国際出願日: 2021年6月25日(25.06.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-143517 2020年8月27日(27.08.2020) JP
- (71) 出願人: 株式会社荏原製作所 (EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 佐竹 正行 (SATAKE, Masayuki); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 中西 正行 (NAKANISHI, Masayuki); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 山下 道義 (YAMASHITA, Michiyoshi); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 廣澤 哲也, 外 (HIROSAWA, Tetsuya et al.); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 8 号 GOWA 西新宿 4 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING METHOD AND SUBSTRATE PROCESSING DEVICE

(54) 発明の名称: 基板処理方法、および基板処理装置



(57) Abstract: The present invention relates to a substrate processing method for preventing cracking and chipping of a laminate substrate manufactured by joining a plurality of substrates. The present invention further relates to a substrate processing device capable of implementing such substrate processing method. The method comprises: rotating a laminate substrate (Ws) manufactured by joining a first substrate (W1) and a second substrate (W2); applying a filler (F) having thermoset properties to a gap between a peripheral portion of the first substrate (W1) and a peripheral portion of the second

[続葉有]



WO 2022/044522 A1

CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

substrate (W2); and curing the filler (F). The step of applying the filler (F) and the step of curing the filler (F) are performed successively in the same processing chamber (21).

(57) 要約: 本発明は、複数の基板を接合して製造される積層基板の割れおよび欠けを抑制する基板処理方法に関する。さらに、本発明は、このような基板処理方法を実施可能な基板処理装置に関する。本方法は、第1基板(W1)と第2基板(W2)を接合して製造される積層基板(Ws)を回転させ、第1基板(W1)の周縁部と、第2基板(W2)の周縁部との間の隙間に熱硬化性を有する充填剤(F)を塗布し、この充填剤(F)を硬化させる。充填剤(F)を塗布する工程と、充填剤(F)を硬化させる工程は、同一の処理室(21)内で連続して行われる。